

A

BF₂+ 注入硅栅p沟MOS场效应晶体管辐射感生界面陷阱测量

@张正选\$西北核技术研究所!陕西西安710024 @罗晋生\$西安交通大学微电子所!陕西西安710049 @袁仁峰\$西北核技术研究所!陕西西安710024 @张廷庆\$西安电子科技大学微电子所!陕西西安710071 @姜景和\$西北核技术研究所!陕西西安710024

收稿日期 1999-1-25 修回日期 网络版发布日期:

摘要 利用亚阈测量技术对BF₂注入硅栅PMOSFET辐射感生界面陷阱进行了测量。对BF₂注入PMOSFET具有抑制辐射感生界面陷阱的机理进行了分析和讨论。

关键词 [二氟化硼](#) [硅栅PMOSFET](#) [辐射感生界面陷阱](#)

分类号 [TL99](#) [TN2861](#)

Measurement of Radiation-induced Interface Traps on BF₂+ Implanted Si-gate PMOSFET

ZHANG Zheng xuan 1, LUO Jin sheng 2, YUAN Ren feng 1, ZHANG Ting qing 3, JIANG Jing he 1 (1 Northwest Institute of Nuclear Technology, Xi'an 710024, China; 2 Microelectronic Institute, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China; 3 Microelectronic Institute, Xi'an Electron Sci

Abstract The radiation induced interface traps on BF + 2 implanted Si gate PMOSFET are measured using the subthreshold method. The mechanism of depression of the radiation induced interface traps by the BF + 2 implanted has also been analysed.

Key words [BF₂+](#) [Si-gate PMOSFET](#) [radiation-induced interface traps](#)

DOI

通讯作者

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(333KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“二氟化硼”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章